Germanium-pnp-Legierungstransistor

GC 122
(OC 822)

Der NF-Transistor GC 122 (alte Bezeichnung OC 822) ist ein legierter Ge-pnp-Flächentransistor im ≈ TO-18-Gehäuse.
Der Transistor ist für NF-Stufen und für 30-V-Schaltanwendung im NF-Gebiet bestimmt.

Statische Kennwerte (für $\vartheta_a = 25\,°C - 5$ grd)

Kollektorrestströme

$-I_{CBO} = 2 \leq 15\,\mu A$ bei $-U_{CB} = 6\,V$
$-I_{CEO} = 200 \leq 600\,\mu A$ bei $-U_{CE} = 6\,V$
$-I_{CEV} = 8 \leq 30\,\mu A$ bei $-U_{CE} = 33\,V$ $U_{BE} = 0{,}1\,V$

Emitterreststrom

$-I_{EBO} = 15 \leq 100\,\mu A$ bei $-U_{EB} = 10\,V$

Kollektorrestspannung

$U_{CErest} = 0{,}44 \leq 0{,}55\,V$ bei $-I_C = 150\,mA$

Übergangsfrequenz

$f_T \geq 0{,}5$ (bei $-U_{CE} = 6\,V$ $-I_C = 2\,mA$ $f_M = 0{,}5\,MHz$)

Gleichstromverstärkung

B = 18...35 Stromverstärkungsgruppe a
29...55 Stromverstärkungsgruppe b
45...88 Stromverstärkungsgruppe c
≥ 72 Stromverstärkungsgruppe d
bei $-U_{CE} = 0{,}55\,V$, $-I_C = 150\,mA$

Wärmewiderstand

$R_{th} \leq 0{,}43\,\frac{grd}{mW}$

$R_{thi} \leq 0{,}165\,\frac{grd}{mW}$

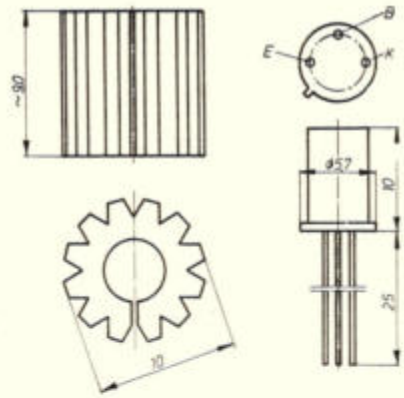
(Sperrschichtgehäuse)

Grenzwerte (für $\vartheta_a = 45\,°C$)

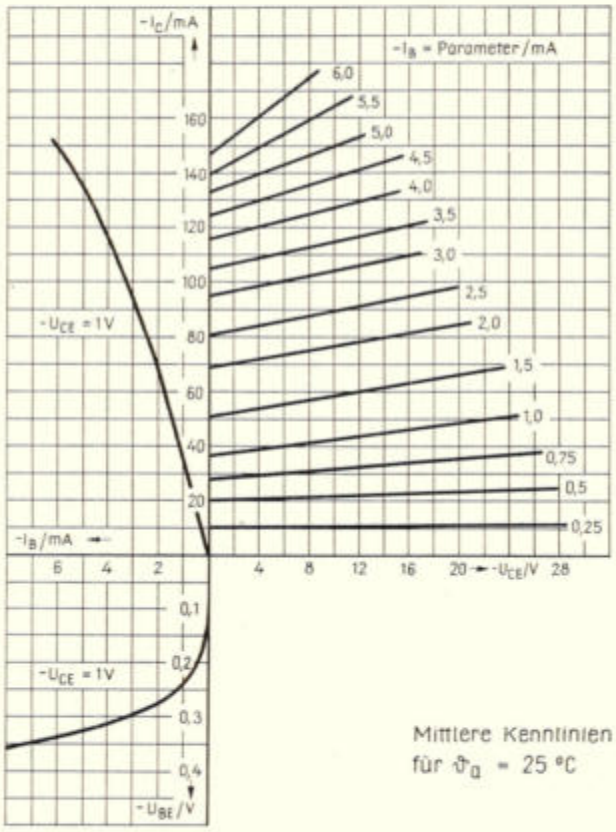
$-U_{CBO} = 30\,V$ $-I_C = 150\,mA$
$-U_{EBO} = 10\,V$ $-I_C = 250\,mA$
$I_E = 165\,mA$
$-U_{CEV} = 33\,V$ $-I_B = 50\,mA$
bei $U_{BE} = 0{,}1\,V$
$\vartheta_j = 75\,°C$
$\vartheta_a = 65\,°C$

Abmessungen

Kühlkörper wird auf freitragenden Transistor gestreift.
Verlustleistung mit Kühlkörper 120 mW



Masse: 0,8 g



Mittlere Kennlinien für $\vartheta_a = 25\,°C$

Mittleres Kennlinienfeld in Emitterschaltung

Bestellbezeichnung für einen Transistor:
Transistor GC 122